



ID Oferty: #JOB20/2016

## Opis stanowiska

**Stanowisko:** Adiunkt

### **Krótką informacją o stanowisku:**

Osoba zatrudniona będzie pełniła jedną z głównych ról w Laboratorium Charakteryzacji Elektrycznej w Oddziale Nanostruktur Półprzewodników Szerokoprzerwowych. Zakres obowiązków obejmie udoskonalenie przyrządów pomiarowych oraz zaawansowaną charakteryzację elektryczną takich materiałów jak tlenki czy azotek galu oraz heterozłącz elektrycznych bazujących na tych materiałach i dedykowanych zastosowaniom elektrycznym, optoelektrycznym oraz fotowoltaicznym. Zakres metod pomiarowych obejmuje techniki spektroskopowe oparte o pomiar pojemności takie jak niestacjonarna spektroskopia głębokich poziomów (DLTS), oraz Laplace DLTS, termiczna spektroskopia admitancyjna, czy badanie czasów zaniku fotoprądu.

### **Szczegółowy opis stanowiska pracy:**

W ramach reaktywacji Laboratorium Charakteryzacji Elektrycznej poszukujemy doświadczonego pracownika naukowego, który będzie odpowiadał za to laboratorium oraz będzie pracował wraz z młodszymi pracownikami naukowymi nad zaawansowaną charakteryzacją elektryczną półprzewodnikowych materiałów szerokoprzerwowych. Wymagane jest doświadczenie, zarówno na poziomie teoretycznym jak też doświadczalnym, w charakteryzacji elektrycznej tlenków za pomocą takich technik jak spektroskopia pojemnościowa, termiczna spektroskopia admitancyjna i stacjonarna spektroskopia głębokich poziomów (ang. deep level transient spectroscopy, DLTS). Ponadto, biorąc pod uwagę bieżące potrzeby udoskonalania układów eksperymentalnych i analizy danych kandydat powinien posiadać dobrą znajomość platformy LabView, jak również takich programów jak Matlab oraz umiejętności techniczne dotyczące konstrukcji przyrządów elektronicznych.

Badania w Oddziale Nanostruktur Materiałów Szerokoprzerwowych są skierowane na identyfikację defektów w takich materiałach jak ZnO, ZnMgO, GaN czy SiC oraz na badaniu przyrządów bazujących na tych materiałach. Zatrudniony naukowiec będzie pracował nad określeniem związków pomiędzy warunkami wzrostu, a właściwościami elektrycznymi. Powinien posiadać duże doświadczenie dotyczące fizyki półprzewodników oraz przyrządów półprzewodnikowych.

Oczekujemy, że naukowiec będzie blisko współpracował z personelem nowo powstałego zespołu MBE, jak też z laboratorium ALD (ang. Atomic Layer Deposition). Powinien zatem posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i podstawową wiedzę o technologii wzrostu i metodach charakteryzacji cienkich warstw.

**Dyscyplina naukowa:** Fizyka

**Specjalność:** Fizyka materii skondensowanej

**Doświadczenie:** Średniozaawansowany lub 4-10 lat (Post-Doc)

**Profil naukowy wg EURAXESS ([szczegóły](#)):** Recognised Researcher (R2)

**Tryb zatrudnienia:** Czas określony na dwa lata

**Wymiar etatu:** Pełny etat

**Wynagrodzenie:** W zależności od kwalifikacji.  
Od 2500 do 3300 PLN miesięcznie (brutto).

## Kontakt

Dodatkowe informacje o stanowisku udziela  
prof. Elżbieta Guzewicz (e-mail: [guzel@ifpan.edu.pl](mailto:guzel@ifpan.edu.pl)).

## Składanie dokumentów

**Termin składania:** 4 listopada 2016 r. Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.

**Wymagane dokumenty:**

- Curriculum Vitae
- Lista publikacji
- Listy referencyjne od 2 naukowców znających osiągnięcia kandydata wysłane przez recenzentów bezpośrednio na adres [jobs@ifpan.edu.pl](mailto:jobs@ifpan.edu.pl)

Wszystkie materiały należy przesłać w formie elektronicznej na adres:  
[jobs@ifpan.edu.pl](mailto:jobs@ifpan.edu.pl) podając w temacie ID Oferty.